







序号	类型 PB型大电流磁	Comment	코 号	Description	Designator	Quantity	厂家	订货编码	封装
1	珠	600Ω®100MHz	PB2012-601/1A5 QJB/K-CT41G- 0805-X5R-25V-106-	600Ω @ 100MHz ±25%	B1, B2, B3, B4 C1, C7, C8, C11, C12, C14, C15, C16,	4	振华富		0805
2	片式多层瓷介电 容器	10uF	0805-X5R-25V-106- M-N, QJB/K+- CT41G-0805-X7R- 10V-106-M-N	10uF±20%,25V,-55-125°C, 10uF, ±20%,10V,-55-125°C	C12, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C26, C33, C42, C44, C48, C52, C56 C2, C9, C13, C23, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C34, C35,	18	火炬	,	0805
3	片式多层瓷介电 容器	100nF	QJB/K+-CT41G- 0603-X7R-50V-104- K-N	100nF.二类±10%,50V,-55~125°C	C31, C32, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C43, C45, C47, C49, C50, C51, C53, C54, C55, C57, C58, C61, C62, C68,	33	火炬	,	0603
4	片式多层瓷介电	1nF	QJB/K+-CT41G- 0603-X7R-50V-102-	1nF,二类,±10%,50V,-55~125°C	C69	1	. i.ee	,	0603
	容器 片式多层瓷介电		GUB/K+-CC41- 0603-CG-50V-101-				火炬	/	
5	F 丸 多 歴 館) 「 中 容 器 C A K 5 5 服 合 物 旧	100pF	0603-CG-50V-101- J-N CAK55-H-16V-	100pF,—类,±5%,50V,-55-125°C CAK55 有失效率等级的导电聚合物片式	C4, C24, C63, C64, C65, C66, C67	7	火炬	/	0603 CASE-
6	电容	100uF	100uF-K QJB/K+-CT41G-	担电容器	C5, C6	2	振华新云	•	E_7343
7	片式多层瓷介电 容器	1uF	0603-X7R-25V-105- K-N QJB/K+-CT41G-	1uF,二类,±10%,25V,-55~125°C	C10	1	火炬	′	0603
8	片式多层瓷介电 容器	22uF	0805-X7R-25V-226- M-N	22uF,二美,±20%,25V,-55~125°C	C18	1	火炬	/	0805
9	片式多层瓷介电 容器	10nF	QJB/K+-CT41G- 0603-X7R-50V-103- K-N	10nF,二类,±10%,50V,-55~125℃	C21, C59	2	火炬	,	0603
10	片式多层瓷介电 容器	22uF	QJB/K-CT41G- 0805-X5R-10V-226-	22uF,二类,±20%,10V,-55~125℃	C46	1	火炬	,	0805
11	金属化聚酯薄膜 电容	470nF/聚酯	GCL22- 12.5X14.4X4.8- 100V-474-J	聚酯薄漆电容	C60	1	振华新云	,	P=10mm
12	尚特基二极管	B340A-13-F	100V-474-J B340A-13-F	直流反向耐圧 (Vr) 40V	D2, D3, D4, D5	4	DIODES(美	C85098	SMA
13	NR型功率电感	4.7uH	NR252012-4R7M	平均整治电流 (lo) 3A 正向压降 (Vf) 550mV @ 3A 电路值 4.7uH	L1. L2. L9	3	台) 振华富		NR2520
14	PB型大电流磁 珠	1000Ω@100MHz	PB3216-102/1A0	1000Ω @ 100MHz ±25%	L3, L4, L5, L6, L7, L10, L11	7	振华富		1206
15	NR型功率电感 器	2.2uH	NR201610-2R2M	电感値 2.2uH 開催 ± 20% 節和电流 1.3A 適升电流 1.15A 直流中間 (内間) 175mΩ 調源电圧 (Vdsz) 20V	L8, L12	2	振华富	-	NR2016
16	MOS(场效应管)	DMG6968UDM-7	DMG6968UDM-7	上 ・ に ・ に は は は の に の に の に の に の に の に の の に の に の に の に の に の に の は に の に の に の に に の は に の に に に に に に に に に に に に に	Q1	1	DIODES(美台)	C151635	SOT23-6
17	PNP	MMBT3906TT1G	MMBT3906TT1G	集电级电流ic 200mA 集射级击穿电压Vce 40V 晶体管接型 PNP 漏源电压 (Vdss) 25V 连续漏极电流 (id) (25°C 时)	Q2, Q3	2	ON(安森美)	C82042	SOT23-3
18	MOS(场效应管)	FDV301N	FDV301N "LMS"RMK1608-K-	220mA	Q4	1	ON(安森美)	C15310	SOT-23-3
19	片式膜固定电阻 器	470R	B-4700-F- LMS050101001- 2017	470R,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R1, R3	2	718	,	0603
20	片式膜固定电阻	2K	"LMS"RMK1608-K- R-2001-F-	2K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R2, R34	2	718	,	0603
20	200	2N	LMS050101001- 2017 "LMS"RMK1608-K-		nz, n.34	-	/16		
21	片式膜固定电阻 器	10M	B-1005-F- LMS050101001-	10M,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R4, R6	2	718	,	0603
22	片式膜固定电阻 器	1M	2017 "LMS"RMK1608-K- B-1004-F- LMS050101001- 2017	1M,±1%,50V,0.1W,±100ppm/*C	R5	1	718	,	0603
23	片式膜固定电阻器	1R	"LMS"RMK1608-K- B-1R0-F- LMS050101001-	1Ω ,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	RB	1	718	,	0603
	片式膜固定电阻		2017 "LMS"RMK1608-K- B-6493-F-						
24	N AUKENE-GIE	649K	LMS050101001- 2017	649K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R10	1	718	/	0603
25	片式膜固定电阻 器	0R	"LMS" RMZ1608-B- T-30-Q/RV20573- 2010	<30mΩ	R12, R18	2	718	/	0603
26	片式膜固定电阻 器	100K	"LMS"RMK1608-K- B-1003-F- LMS050101001-	100K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R13, R16, R21, R40, R41, R44, R46, R47	8	718	,	0603
			2017 "LMS"RMK1608-K- B-4123-F-						
27	片式膜固定电阻 器	412K	LMS050101001-	412K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R15	1	718	,	0603
28	片式膜固定电阻 器	1.4M	"LMS"RMK1608-K- B-1404-F- LMS050101001-	1.4M,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R17	1	718	,	0603
	器 片式膜固定电阻		2017 "LMS"RMK1608-K- B-2202-F-						
29	斤丸製造定电阻 器	22K	LMS050101001- 2017 "LMS'RMK1608-K-	22K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R19	1	718	/	0603
30	片式膜固定电阻 器	150K	B-1503-F- LMS050101001-	150K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R20	1	718	,	0603
	片式機関定申期		2017 "LMS"RMK1608-K- B-470-F-						
31	8	47R	LMS050101001- 2017 "LMS"RMK1608-K-	47R,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R22	1	718	/	0603
32	片式膜固定电阻 器	330R	B-3300-F- LMS050101001-	330R,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R23	1	718	/	0603
33	片式膜固定电阻	4.7K	2017 "LMS"RMK1608-K- B-4701-F- LMS050101001-	4.7K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R24, R25, R26, R28,	5	718		0603
33	88	4.75	LMS050101001- 2017 PNK5084-M-E-	4.7K,21%,50V,0.1W,2100ppiiVC	R29		710		0603
34	电阻网络	4.7K	4701-F-GJB7690- 2012 "LMS"RMK1608-K-	4.7K ,±1%,40V,0.1W,±300ppm/°C	R27	1	718	/	0603
35	片式膜固定电阻 器	1K	B-1001-F- LMS050101001-	1K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R30, R35, R42	3	718	/	0603
			2017	精度±1% 用度27m ±100com//C					
36	Resistor	51R	RS-03K51R0FT	福度 ±1% 温度系数 ±100ppm/°C 功率 0.1W 阻值 510	R31	1	FH(风华)	C146828	0603
37	片式膜固定电阻 器	30R	"LMS"RMK1608-K- B-300-F- LMS050101001-	30R,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R32, R33	2	718	,	0603
	10 片式機関定申組		2017 "LMS"RMK1608-K- B-1002-F-						
38	200	10K	LMS050101001- 2017	10K,±1%,50V,0.1W,±100ppm/°C	R36, R38, R43, R45	4	718	V	0603
39 40	Resistor 电池保护芯片	30K S-8261AAJMD-	RS-03K3002FT S-8261AAJMD-	精度 ±1% 单节电池保护芯片 过充4.325V	R37, R39	1	FH(风华) ABLIC(艾普	C140100 C125801	0603 SOT23-6
40	电池保护芯片	G2JT2S TPS22917DBVR	G2JT2S TPS22917DBVR	过放2.5V 过渡150mV 2A负载开关	U1 U2	1	液科) TI(徳州仪器)	C2681320	SOT23-F
42	LDO	ADP7182AUJZ- 5.0-R7	TPS22917DBVR ADP7182AUJZ-5.0- R7	-28 V、-200 mA、低場声线性稳压器	U3	1	ADI(亚德 诺)/LINEAR	C514357	SOT-23-5
43	DCDC	TLV61048DBVT	TLV61048DBVT	DC-DC芯片 最小線入电圧 2.5V 最大線入电圧 5.5V 輸出电圧(最小像)型定) 0.5V 輸出电圧(最小像)型定) 0.5V 耐出电圧(最大傷) 5.5V 可輸出电流 1.5MH左 16V	U4, U7	2	TI(徳州仪器)	C2071944	SOT-23-6
44	LDO	LP2992AIM5- 5.0/NOPB	LP2992AIM5- 5.0NOPB	16V T作电源电流(Max) 4mA 日路(max) 850mV @ 250mA 钻出电压(可调) 静态电流(和) 静态电流(和) 静态电流(和) 钻出配置 正 纹波切削(PSRR) 45dB(1kHz) 工作温度 40°C-125°C(T)	U5	1	TI(徳州仪器)	C130001	SOT-23-5
45	DCDC	TLV62568DBVR	TLV62568DBVR	顕出用に個計5V DC-DC-DF 最小編入电圧 2.5V 最大編入电圧 5.5V 輸出电圧(最小値/固定) 0.5V 輸出电圧(最大値) 5.5V 可輸出电路 1A	U6, U17	2	TI(德州仪器)	C163219	SOT-23-5
46	FPGA	EP1C3T100C7N	EP1C3T100C7NA	Cyclone Family, 1.5V FPGA, 65 I/O Pins, 1 x PLL, Commercial Grade, Speed Grade 7, Pb-Free	UB	1	INTEL		TQFP100
47	FLASH存储器	EPCS4SI8N	EPCS4SI8N	FLASH - NOR	U9	1	ALTERA(阿 尔特拉)	C569019	SOIC-8
48	电源参考	REF3325AIDBZ R	REF3325AIDBZR	協出电圧 (優小衛国建) 2.5V 協出电圧 (優大衛) (最大衛) (現立 (最大衛) (現立 (最大衛) (現立 (最大衛) (現立 (最大衛) (現立 (最大衛) (現立 (現立 (最大衛) (現立	U10, U14	2	TI(總州仪器)	C69039	SOT23-3
49	模数转换芯片	AD9240ASZRL	AD9240ASZRL	學者遊恩 系列 根数柱换芯片 读而接口英型 Parallel 工作电压 5V 给入类型 Differential, Single Ended 参考类型 External, Internal 输入数目 采样率(5ps) 10M AD 位数 14	U11	1	ADI(亚德诺)	C38677	MQFP-44
50	并联电压参考	LM4051AIM3	LM4051AIM3- ADJ/NOPB	協出电路 12mA 輸出电压 (最大值) 10V 輸入电压 - 电源电路 - 电源电路 - 10T/13BE -40°C - 85°C(TA) 温度系数 50ppm°C 財級电流 65uA 積度 -10.1% 像考露坐型 分速器	U12	1	TI(德州仪器)		SOT-23
51 52	运放 特殊功能放大器	LTC2050HVHS6 AD8336	LTC2050HVHS6#T RPBF AD8336ACPZ WP		U13 U15	1	ADI(亚德诺) ADI(亚德诺)	C679145 C1523374	TSOT-23-6 LFCSP-16
				FET输入运放 增益带宽积 (GBP) 8MHz 放大器拍数 1					
53	运放	AD8510ARZ	AD8510ARZ- REEL7	欧大路山駅 1 輸出栄配 - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	U16	1	TI(衛州仪器)	C44017	SOIC- 8_150mil
									SMD:
54	有深品振	20MHZ	ZPB31-20-V3-A4- C1-E	工作电源3.3±0.3V	Y1	1	展品		3225_4P